

書名：「電子回路、マジわからん」と思ったときに読む本

発行：2023年2月25日 第1版第1刷発行

2023年7月30日 第1版第2刷発行




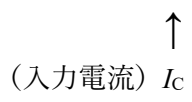
2024年1月20日 第1版第3刷発行

2024年11月10日 第1版第4刷発行

2025年12月20日 第1版第5刷発行

ISBN：978-4-274-23014-1

## ■第1刷正誤表

| 頁   | 該当箇所                                 | 正誤内容   |   |
|-----|--------------------------------------|--|---|
|     |                                      | 誤  | 正   |
| iii | 上から5行目                               | デレビ  | テレビ   |
| 23  | ▲50 Hz と 60 Hz                       | <br>アメリカ                  ドイツ | <br>アメリカ                  ドイツ |
| 44  | 下から2行目                               | 最大値 $V_m$ に $\pi/2$ を掛けた値を平均値 $V_a$ といいます。   | 最大値 $V_m$ に $2/\pi$ を掛けた値を平均値 $V_a$ といいます。  |
| 65  | ▲不純物半導体(n形半導体)                       | <br>多数キャリア                  | <br>多数キャリア                 |
| 79  | ▲トランジスタの動作<br>(a)接続図                 | $\rightarrow I_C$  | $\leftarrow I_C$  |
| 86  | 下から5行目                               | MOS型FTEも接合型FETと同様に、  | MOS型FETも接合型FETと同様に、   |
| 98  | 上から1行目                               | 論理回路(③⑩参照)用IC  | 論理回路(④⑧参照)用IC   |
|     | ▲ICの製造工程                             | ⑤ 不純物拡散  | ⑤ 不純物 <b>拡散</b>   |
| 118 | ▲負荷線と動作点<br>(b) $V_{CE}-I_C$ 特性(静特性) | <br>(入力電流) $I_C$            | <br>(出力電流) $I_C$            |
| 122 | 上から1行目                               | A級増複   | A級増幅  |
| 144 | ▲フィルタ回路の特性                           | BPFの通過域<br>(左側) $f_{CH}$ (右側) $f_{CL}$   | (左側) $f_{CL}$ (右側) $f_{CH}$   |
| 191 | 上から11行目                              | 5.3 V ですしすから   | 5.3 V <b>です</b> から  |
| 215 | 下から1行目                               | 赤外線捜査方式  | 赤外線 <b>走</b> 査方式  |

■第2刷正誤表

| 頁   | 該当箇所   | 正誤内容                                       |  |
|-----|--------|--|--|
|     |        | 誤  | 正  |
| 44  | 下から2行目 | 最大値 $V_m$ に $\pi/2$ を掛けた値を平均値 $V_a$ といいます。 | 最大値 $V_m$ に $2/\pi$ を掛けた値を平均値 $V_a$ といいます。 |
| 86  | 下から5行目 | MOS 型 FTE も接合型 FET と同様に、                   | MOS 型 <b>FET</b> も接合型 FET と同様に、            |
| 215 | 下から1行目 | 赤外線捜査方式                                    | 赤外線 <b>走</b> 査方式                           |

■第3刷正誤表

| 頁   | 該当箇所   | 正誤内容                     |                                 |
|-----|--------|--------------------------|---------------------------------|
|     |        | 誤                        | 正                               |
| 86  | 下から5行目 | MOS 型 FTE も接合型 FET と同様に、 | MOS 型 <b>FET</b> も接合型 FET と同様に、 |
| 215 | 下から1行目 | 赤外線捜査方式                  | 赤外線 <b>走</b> 査方式                |

■第4刷, 第5刷正誤表

| 頁  | 該当箇所   | 正誤内容                     |                                 |
|----|--------|--------------------------|---------------------------------|
|    |        | 誤                        | 正                               |
| 86 | 下から5行目 | MOS 型 FTE も接合型 FET と同様に、 | MOS 型 <b>FET</b> も接合型 FET と同様に、 |